

04.09.03

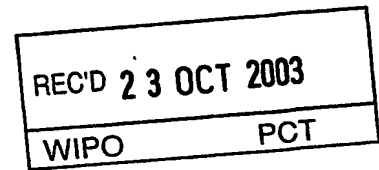
日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日                      2 0 0 2 年    9 月 1 9 日  
Date of Application:

出 願 番 号                      特 願 2 0 0 2 - 2 7 2 4 7 3  
Application Number:  
[ST. 10/C]:                      [ J P 2 0 0 2 - 2 7 2 4 7 3 ]



出 願 人                      東芝セラミックス株式会社  
Applicant(s):                      株式会社テクノネットワーク四国

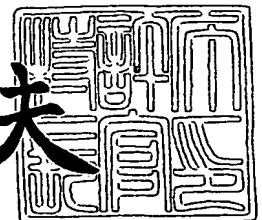
**PRIORITY DOCUMENT**  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1(a) OR (b)



2 0 0 3 年 1 0 月    9 日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今 井 康 夫



BEST AVAILABLE COPY

【書類名】 特許願

【整理番号】 TSA2039P

【提出日】 平成14年 9月19日

【あて先】 特許庁長官 太田 信一郎 殿

【国際特許分類】 C30B 29/06  
C30B 23/00  
C30B 30/02  
B82B 1/00

【発明者】

【住所又は居所】 高知県香美郡土佐山田町宮ノ口 1 8 5 高知工科大学内

【氏名】 八田 章光

【特許出願人】

【識別番号】 000221122

【氏名又は名称】 東芝セラミックス株式会社

【特許出願人】

【識別番号】 501103000

【氏名又は名称】 株式会社テクノネットワーク四国

【代理人】

【識別番号】 100101878

【弁理士】

【氏名又は名称】 木下 茂

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 063692

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9204946

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 針状シリコン結晶およびその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 先端が曲率半径 1 nm 以上 20 nm 以下の先細状であり、底面の直径が 10 nm 以上、かつ、高さが底面の直径に対して 1 倍以上のほぼ円錐状であることを特徴とする針状シリコン結晶。

【請求項 2】 前記底面の直径が 10 nm 以上 50000 nm 以下、かつ、前記高さが 10 nm 以上 200000 nm 以下であることを特徴とする請求項 1 記載の針状シリコン結晶。

【請求項 3】 基板面に対して垂直に配向していることを特徴とする請求項 1 または請求項 2 記載の針状シリコン結晶。

【請求項 4】 表面が炭素薄膜により被覆されていることを特徴とする請求項 1 から請求項 3 までのいずれかに記載の針状シリコン結晶。

【請求項 5】 触媒を用いたプラズマ CVD 法により、シリコン基板面に一様に、かつ、該基板面に対して垂直に配向させて、無数の微小針状結晶を再成長させることを特徴とする針状シリコン結晶の製造方法。

【請求項 6】 前記プラズマ CVD 法においては、シリコン基板面に触媒金属微粒子をスパッタリングにより一様に付着させた後、炭化水素系ガスおよびキャリアガスを供給しながら、マイクロ波電力により放電プラズマを発生させて、前記シリコン基板面上に、表面が炭素薄膜により被覆された針状結晶を成長させることを特徴とする請求項 5 記載の針状シリコン結晶の製造方法。

【請求項 7】 前記シリコン基板には、n 型の低抵抗シリコン基板を用いることを特徴とする請求項 5 または請求項 6 記載の針状シリコン結晶の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、針状シリコン結晶およびその製造方法に関し、より詳細には、ナノテクノロジーにおいて有用なナノサイズの先鋭な形状を有するシリコン針状結晶、および、シリコン基板面上に該針状シリコン結晶を大量に製造することができ

る製造方法に関する。

#### 【0002】

##### 【従来の技術】

近年、エレクトロニクス産業における技術の高度化に伴い、デバイスの一層の微細化、高集積化が要求されるようになり、その加工技術の微細化の程度は、サブミクロンオーダーの領域を超え、ナノメータ（nm）オーダーの領域に達するようになってきた。そのため、数十nm～数nmの大きさの素子や構造部材が必要とされるようになってきている。

#### 【0003】

上記のような構造部材や素子を製造するための微細材料としては、1991年に発見されたカーボンナノチューブが注目されている。

また、最近では、このカーボンナノチューブ以外にも、カーボンナノコーン、カーボンナノワイヤー、カーボンナノシート、カーボンナノベルト等の各種形状の超微小カーボン材が、提案または作製されており、実用のための研究開発が進められている。

このようなグラファイト骨格構造のカーボン材に関しては、例えば、カーボンナノチューブや細長い円錐状のカーボンナノコーンのように、先鋭な形状を有する超微小構造体の合成例は多数知られている。

#### 【0004】

一般に、物質のサイズは、ナノオーダーのサイズにまで小さくなると、バルクとは全く異なる新しい属性を示すようになる。例えば、バルクのグラファイト（黒鉛）は導電体であるのに対して、カーボンナノチューブは、サイズや構造によっては、半導体の属性を示す。

また、ナノチューブの先端に電界をかけると、強い電界集中が起こり、トンネル効果によって、チューブ先端から電子が容易に真空中に飛び出す。

このような特性から、前記超微小カーボン材は、エレクトロニクス部材としての面からも注目されている。

#### 【0005】

前記超微小カーボン材の製造においては、例えば、カーボンナノチューブの場

合には、従来、グラファイト電極をアーク放電する方法、炭化水素を気相熱分解する方法、グラファイトをレーザーで昇華させる方法等が用いられていた。

また、最近では、例えば、特許文献1では、シリコン単結晶基板上に、炭化ケイ素結晶をエピタキシャル成長させた後、エッチング、高温加熱等の処理を経て、カーボンナノチューブ膜（配向性のある多数本のカーボンナノチューブからなる膜）を形成させる方法が提案されている。

さらに、特許文献2には、プラズマCVD法により、金属基板表面に直接、垂直に配向させてカーボンナノチューブを作製する方法も開示されている。

#### 【0006】

ところで、このような超微小の部材や構造体の製造、加工手法に関しては、基本的に二通りの考え方がある。

一つは、分子もしくは原子、または、それらとほぼ同等の大きさの官能基、イオン等からなるマイクロ物質を素材とし、これを合成、変性、転移、置換、脱離、移動等により所望の構造に組み上げて製造する、いわゆるボトムアップ方式である。

もう一つは、マクロな素材（バルク）を切削、粉碎、分解、エッチング、溶解等により、超微小サイズ領域にまで加工縮小して製造する、いわゆるトップダウン方式である。

#### 【0007】

カーボンナノ構造体、特に、上記したカーボンナノチューブやカーボンナノコーンのような先鋭な形状を有する超微小構造体の場合には、後者の方式では、サブミクロンを超える微細加工は、實際上、非常に困難であるため、そのほとんどが、前者、すなわち、ボトムアップ方式により製造されている。

カーボンナノ構造体以外にも、窒化ホウ素（BN）からなるナノコーン構造体やガリウム・ヒ素（GaAs）／アルミニウム・ガリウム・ヒ素（AlGaAs）複層針状結晶構造体等も、このような手法で製造されている（特許文献3参照）。

#### 【0008】

しかしながら、シリコン（Si）に関しては、炭素と同族の元素であるにもか

かわらず、同様のナノ構造体の合成例はあまり知られていない。

わずかに、シリコンの結晶成長において、VLS機構 (vapor-liquid-solid mechanism) により、偶発的に、ファイバー状のシリコン結晶が成長した事例や、シリコン (Si) 基板上に Si 微結晶粒を種結晶として載置し、該基板面を Si の融点付近まで加熱して、表面偏析により莖状形状を有するファイバー状結晶を成長させる例が知られている程度に過ぎない (例えば、特許文献 4 参照)。

#### 【0009】

したがって、シリコンナノチューブやシリコンナノコーンのような先鋭な形状を有するシリコン超微小構造体については、ボトムアップ方式による再現性のある合成例は、全く知られていない。

#### 【0010】

一方、シリコン材料を先鋭化する方法として、エッチングにより微細加工する方法 (トップダウン方式) は知られているが、エッチングにより先端部をナノサイズにまで先鋭化することは、相当の困難を伴うものである。

#### 【0011】

##### 【特許文献 1】

特開 2000-109308 号公報

##### 【特許文献 2】

特開 2001-48512 号公報

##### 【特許文献 3】

特開平 5-95121 号公報

##### 【特許文献 4】

特開 2002-220300 号公報

#### 【0012】

##### 【発明が解決しようとする課題】

上記のように、シリコンナノチューブ、シリコンナノコーンのような先鋭な形状を有するシリコン微小構造体を合成により作製することが困難である理由の一つには、シリコンが空気中で容易に酸化され、ケイ素酸化物に変化しやすいことが挙げられる。

特に、ナノ構造体のように超微小の構造物は、その比表面積が極めて大きいため、酸化されやすく、極微量の酸素や酸化性物質との接触により容易に酸化されて崩壊する。とりわけ、先端部は、胴部等に比べて結合歪みが大きいため、酸化に対して極めて敏感であり、容易に構造体の崩壊を誘発する。

#### 【0013】

したがって、従来、上述したいずれの方法を用いても、先鋭な形状を有するナノサイズの針状シリコン結晶を再現性よく、かつ、大量に製造することは困難であった。

#### 【0014】

本発明者らは、上記技術的課題を解決するために鋭意研究を重ねた結果、シリコン基板を特定条件下でプラズマCVD処理する過程において、先鋭な超微小シリコン針状結晶を成長させることに成功し、この知見に基づき、本発明を完成するに至った。

#### 【0015】

本発明は、カーボンナノチューブや細長い円錐状のカーボンナノコーンと同様な先鋭な形状を有する超微小な針状シリコン結晶を提供することを目的とするものである。

また、本発明は、前記針状シリコン結晶を、再現性よく、所望の場所に、均質かつ大量に成長させることができる製造方法を提供することを目的とする。

#### 【0016】

##### 【課題を解決するための手段】

本発明に係る針状シリコン結晶は、先端が曲率半径1nm以上20nm以下の先細状であり、底面の直径が10nm以上、かつ、高さが底面の直径に対して1倍以上のほぼ円錐状であることを特徴とする。

ここで、「ほぼ円錐状」とは、完全な円錐状に限られず、断面形状が、楕円のもの、三角形、四角形等の多角形に近似するものの錘状も含み、さらに、上部が円錐状であり、下部が柱状であるような場合も含むことを意味する。

このようなナノサイズの先鋭な形状を有する超微小針状シリコン結晶は、ナノテクノロジーにおいて、ピンセット、プローブ、センサ、半導体デバイス、電子



放出素子等の様々な用途に応用することができる。

#### 【0017】

前記針状シリコン結晶は、底面の直径が10nm以上50000nm以下、かつ、前記高さが10nm以上200000nm以下であることが好ましい。

上記サイズは、実用性、製造容易性を考慮した場合に好ましい範囲を規定したものである。

#### 【0018】

前記針状シリコン結晶は、基板面に対して垂直に配向して形成される。

このため、先端の先鋭な形状を維持した状態で、直錐状の構造を有することができる。

#### 【0019】

また、前記針状シリコン結晶は、表面が炭素薄膜により被覆されているものであってもよい。

これにより、炭素薄膜により被覆された内部のシリコンの酸化が回避され、該針状シリコン結晶は、安定な状態で存在することができる。

#### 【0020】

また、本発明に係る針状シリコン結晶の製造方法は、触媒を用いたプラズマCVD法により、シリコン基板面に一様に、かつ、該基板面に対して垂直に配向させて、無数の微小針状結晶を再成長させることを特徴とする。

このような方法によれば、先鋭な形状を有しており、しかも、一定の配向性を有する超微小な針状シリコン結晶を、所望の場所に、均質かつ大量に合成することができる。

#### 【0021】

前記プラズマCVD法においては、シリコン基板面に触媒金属微粒子をスパッタリングにより一様に付着させた後、炭化水素系ガスおよびキャリアガスを供給しながら、マイクロ波電力により放電プラズマを発生させて、前記シリコン基板面上に、表面が炭素薄膜により被覆された針状結晶を成長させることが好ましい。

上記した製造方法によれば、金属微粒子を触媒として用い、かつ、炭化水素系

ガスおよびキャリアガスを供給することにより、シリコン基板面に付着した触媒金属微粒子にほぼ対応する無数の針状シリコン結晶を安定な状態で得ることができる。

#### 【0022】

上記製造方法においては、前記シリコン基板として、アンチモン（Sb）、ヒ素（As）、リン（P）等がドーピングされたn型の低抵抗シリコン基板を用いることにより、前記針状シリコン結晶をより効果的に得ることができる。

#### 【0023】

##### 【発明の実施の形態】

以下、本発明を、一部図面を参照して、より詳細に説明する。

図1は、本発明に係る針状シリコン結晶の電子顕微鏡写真を図示したものである。

図1に示したように、本発明に係る針状シリコン結晶1は、その一つ一つは、先端がナノオーダーでの曲率半径を有する先細状であり、底面の直径に対する高さが1倍以上の縦長のほぼ円錐状である。

このように、本発明においては、独立したナノサイズのシリコン結晶を得ることができる。

#### 【0024】

前記先端の曲率半径は、1nm以上20nm以下であり、より好ましくは、1nm以上5nm以下の先鋭な針状である。

また、この針状シリコン結晶1は、底面の直径が10nm以上5000nm以下、より好ましくは、50nm以上1000nm以下であり、高さは10nm以上20000nm以下、より好ましくは、50nm以上4000nm以下のほぼ円錐状である。

上記範囲外の針状シリコン結晶を得ることも可能であるが、実用上および製造容易性等を考慮すると、このような寸法の範囲内のものであることが好ましい。

#### 【0025】

また、図1に示す針状シリコン結晶1は、表面が炭素薄膜2により被覆されている。

ナノサイズのシリコンは、空气中で容易に酸化してしまうが、この炭素薄膜により被覆されていることにより、内部のシリコンの酸化が回避され、安定な状態で存在することができる。

前記炭素薄膜の厚さは、単分子層または多重分子層のいずれの場合も、0.3～3 nm程度であることが好ましい。

#### 【0026】

前記針状シリコン結晶表面を被覆している炭素薄膜は、必要に応じて、容易に除去することができる。

例えば、加熱することにより、炭素薄膜(C)をシリコン(Si)と反応させて、炭化ケイ素(SiC)層とした後、HF+HNO<sub>3</sub>液等のエッチング液を用いてエッチング処理することにより、前記炭化ケイ素層を除去し、内部のシリコン結晶のみを分離することができる。

また、用途等に応じて必要であれば、炭化ケイ素層に被覆された状態の針状シリコン単結晶として利用することも可能である。

#### 【0027】

図2は、本発明に係る製造方法により、シリコン基板面に成長させた前記針状シリコン結晶の群の電子顕微鏡写真を図示したものである。

図2に示したように、本発明に係る製造方法によれば、上記のような本発明に係る針状シリコン結晶は、シリコン基板面に一様に、かつ、該基板面に対して垂直に配向させて、無数の同等のサイズの均質な微小針状結晶として成長させることができる。

このため、図2に示した針状シリコン結晶群は、上面から見た電子顕微鏡写真においては、無数のほぼ円形の集合体として観察される。

なお、結晶群のシリコン基板の端縁部においては、基板面に対して斜めに成長した針状結晶も観察される。これは、結晶成長時における基板面近傍の電界方向を反映したものであると考えられる。

#### 【0028】

次に、本発明に係る針状シリコン結晶の製造方法について説明する。

本発明においては、触媒を用いたプラズマCVD法により、シリコン基板面に

一様に、かつ、該基板面に対して垂直に配向させて、無数の微小針状シリコン結晶を再成長させる。

前記プラズマCVD法は、触媒のスパッタリングおよびマイクロ波電力によるプラズマCVDを組み合わせたバイアスプラズマCVDにより行われることが好ましく、このような方法により、薄膜状ではなく、針状にシリコン結晶を成長させることができる。

したがって、本発明に係る製造方法によれば、先鋭な形状を有しており、しかも、一定の配向性を有する超微小な針状シリコン結晶を、所望の場所に、均質かつ大量に合成することができる。

#### 【0029】

具体的には、アルゴン (Ar) 等の不活性ガス雰囲気下で、シリコン基板を陽極側、触媒金属を陰極側のターゲットとして対向させて、減圧下、直流電圧を印加することにより、触媒金属微粒子のスパッタリングを行う。

このスパッタリングは、圧力80～150Pa程度の減圧下で、10～30分間程度行うことが好ましく、これにより、シリコン基板面に触媒金属微粒子を一様に付着させることができる。

そして、この触媒金属微粒子が付着したシリコン基板面に、炭化水素系ガスおよびキャリアガスを供給しながら、マイクロ波電力によって放電プラズマを発生させ、シリコン基板に負のバイアスを印加する。

これにより、シリコン基板面に付着した触媒金属微粒子にはほぼ対応する無数の針状シリコン結晶を再成長させることができる。

#### 【0030】

上記した製造方法によれば、金属微粒子を触媒として用い、かつ、炭化水素系ガスおよびキャリアガスを供給することにより、表面が炭素薄膜により被覆された安定な状態の針状シリコン結晶が得られる。

なお、この表面の炭素薄膜は、上述のように、容易に除去することができ、また、炭化ケイ素薄膜とすることもできる。

#### 【0031】

上記製造方法における触媒金属としては、Fe、Ni、Co、Cu等またはこ

これらの2種以上を組み合わせたものを用いることができるが、この中でも、特に、Feが好ましい。

#### 【0032】

また、前記プラズマCVD法においては、温度条件は、シリコン基板温度で250～800℃程度とし、約400℃で行うことが好ましい。

また、圧力は、240～13300Pa程度の減圧状態とすることが好ましい。

#### 【0033】

前記プラズマCVD法において用いられる炭化水素系ガスとしては、例えば、メタン、エタン、エチレン、アセチレン、プロパン、プロピレン等の低級炭化水素が挙げられるが、これらの中でも特に、メタンを使用することが好ましい。

また、キャリアガスとしては、水素(H<sub>2</sub>)もしくはヘリウム(He)、アルゴン(Ar)、ネオン(Ne)、クリプトン(Kr)、キセノン(Xe)等の不活性ガス、または、これら不活性ガスと水素との混合ガス等を使用することができる。

#### 【0034】

本発明において使用するシリコン基板としては、特に限定されないが、鏡面研磨後、表面が清浄化処理されたシリコン単結晶ウエハを使用することが好ましく、特に、アンチモン(Sb)、ヒ素(As)、リン(P)等がドーピングされた、抵抗率0.1～20Ω・cm程度のn型の低抵抗シリコンウエハを用いることが好ましい。

また、シリコン基板面の結晶方位が〈100〉であり、表面が酸化処理されたものを用いることがより好ましい。

#### 【0035】

上記のようにして得られた針状シリコン結晶は、ナノテクノロジーにおける様々な用途の展開が期待される物質である。

例えば、SEM(走査型電子顕微鏡)、TEM(透過型電子顕微鏡)、AFM(原子間力顕微鏡)等において、ナノサイズの物質を取り扱う際には、先端がナノサイズの針、ピンセット、プローブ等が必要となるが、本発明に係る針状シリ

コン結晶は、その形状から、このような用途に好適に用いることができる。

また、ナノサイズの物質の分析を行うセンサとしても好適に用いることができ、バイオテクノロジー、特に、遺伝子の検査等においては有用である。

さらに、本発明に係る針状結晶は、シリコン単結晶からなるため、微量の不純物をドーピングすることにより、先端をナノサイズの半導体センサや半導体デバイスとして利用することができる。

さらにまた、先鋭な形状を有する電導体や半導体には、強い電界集中が起こるため、トンネル効果によって、固体中の電子が容易に真空中に放出される。この原理を利用して、冷陰極等の電子を放出する素子の材料として応用することも可能である。

### 【0036】

#### 【実施例】

以下、本発明を実施例に基づきさらに具体的に説明するが、本発明は下記の実施例により制限されるものではない。

シリコン基板として15mm×15mmの清浄な〈100〉シリコンウエハ（低抵抗n型）を用いて、圧力120Paとした後、アルゴンガスを用いた直流放電プラズマにより、触媒金属として鉄を20分間スパッタリングし、該基板面上に、鉄の微粒子を一様に付着させた。

この鉄の微粒子を触媒として、メタン（20％）／水素混合ガスを供給しながら、基板温度約400℃、圧力240Paで、マイクロ波電力400Wにて放電プラズマを発生させ、シリコン基板に負のバイアス電圧200Vを約1時間印加した。

### 【0037】

上記のようにしてプラズマCVD処理を行ったシリコン基板試料を目視により観察したところ、基板面は黒い薄膜に覆われていた。

さらに、該基板試料を電子顕微鏡により観察したところ、ほぼ円錐状の針状物質が、基板面に一様に、かつ、該基板面に対して垂直に配向して無数に形成されていた。該基板の端部においては、斜め方向に成長した針状物質も観察された。

前記針状物質は、先端の曲率半径が10nm以下の先細状であり、底面の直径

が100nm以上200nm、かつ、高さ1000nm以上2000nm以下の  
ほぼ円錐状であった。

また、電子エネルギー損失分光（EELS）測定により、該針状物質は、シリ  
コン結晶であり、その表面全体が、炭素薄膜により被覆されていることが認めら  
れた。

### 【0038】

#### 【発明の効果】

以上のとおり、本発明に係る針状シリコン結晶は、ナノサイズの先鋭な形状を  
有する超微小針状シリコン結晶であることから、ナノテクノロジーにおいて、ナ  
ノサイズの物質を扱うために用いられる先端がナノサイズの針やピンセット、プ  
ロープ等、あるいは、遺伝子検査等に用いられるバイオセンサ、半導体センサや  
半導体デバイス、電子放出素子等としての応用が期待される。

また、本発明に係る針状シリコン結晶の製造方法によれば、前記針状シリコン  
結晶を、再現性よく、所望の場所に、均質かつ大量に成長させることができるた  
め、先鋭な形状を有するシリコン超微小構造体の大量製造が容易となり得る。

#### 【図面の簡単な説明】

##### 【図1】

本発明に係る針状シリコン結晶の電子顕微鏡写真を図示したものである。

##### 【図2】

シリコン基板上に成長させた本発明に係る針状シリコン結晶群の電子顕微鏡写  
真を図示したものである。

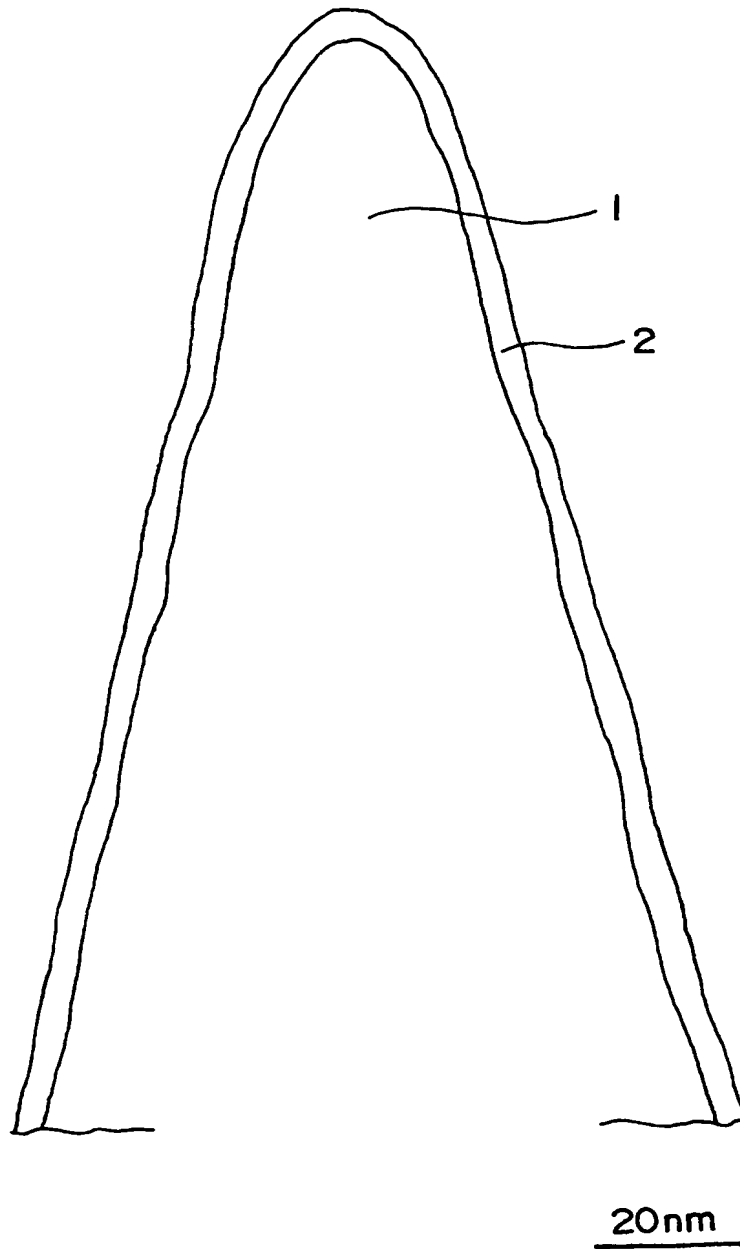
#### 【符号の説明】

- 1 針状シリコン結晶
- 2 炭素薄膜

【書類名】

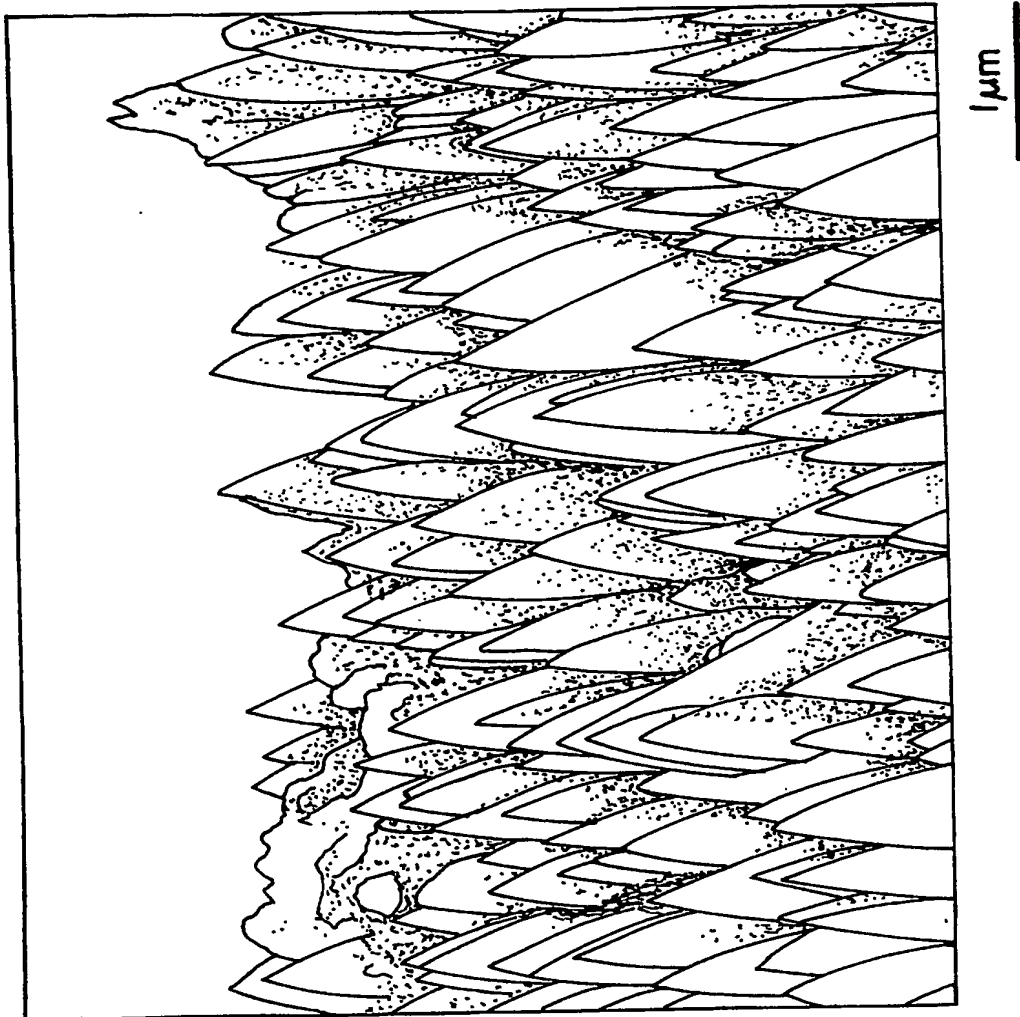
図面

【図 1】





【図 2】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 先鋭な形状を有する超微小な針状シリコン結晶、および、該針状シリコン結晶を、再現性よく、所望の場所に、均質かつ大量に成長させることができる製造方法を提供する。

【解決手段】 触媒を用いたプラズマCVD法により、シリコン基板面に一様に、かつ、該基板面に対して垂直に配向させて、無数の微小針状結晶を再成長させることにより、先端が曲率半径1 nm以上20 nm以下の先細状であり、底面の直径が10 nm以上、かつ、高さが底面の直径に対して1倍以上のほぼ円錐状の針状シリコン結晶が得られる。

【選択図】 なし

【書類名】 手続補正書

【提出日】 平成14年11月28日

【あて先】 特許庁長官 太田 信一郎 殿

【事件の表示】

【出願番号】 特願2002-272473

【補正をする者】

【識別番号】 000221122

【氏名又は名称】 東芝セラミックス株式会社

【補正をする者】

【識別番号】 501103000

【氏名又は名称】 株式会社テクノネットワーク四国

【代理人】

【識別番号】 100101878

【弁理士】

【氏名又は名称】 木下 茂

## 【手続補正 1】

【補正対象書類名】 特許願

【補正対象項目名】 発明者

【補正方法】 変更

## 【補正の内容】

## 【発明者】

【住所又は居所】 高知県香美郡土佐山田町宮ノ口 185 高知工科大学内

【氏名】 八田 章光

## 【発明者】

【住所又は居所】 高知県中村市具同 7058-24

【氏名】 吉村 紘明

## 【発明者】

【住所又は居所】 高知県高知市鴨部 878 番地 15

【氏名】 石元 啓一

## 【発明者】

【住所又は居所】 高知県香美郡土佐山田町宝町 2-2-14 ハイム S S  
308 号

【氏名】 鐵艸 浩彰

## 【発明者】

【住所又は居所】 高知県南国市大▲そね▼甲 2225 メゾン・グローリ  
ア 203 号

【氏名】 川越 伸一

【その他】 出願の際、事務手続上の錯誤により、発明者である吉村  
紘明氏、石元啓一氏、鐵艸浩彰氏、川越伸一氏の 4 名が  
脱落してしまいました。このため、八田章光氏に加え上  
記 4 名を発明者の欄に追加する補正を行いました。また  
、本書と同日付けで手続補足書により、宣誓書を提出し  
ております。

【プルーフの要否】 要

特願 2 0 0 2 - 2 7 2 4 7 3

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[ 0 0 0 2 2 1 1 2 2 ]

1. 変更年月日

1 9 9 9 年 9 月 8 日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都新宿区西新宿七丁目 5 番 2 5 号

氏 名

東芝セラミックス株式会社

特願 2 0 0 2 - 2 7 2 4 7 3

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[ 5 0 1 1 0 3 0 0 0 ]

1. 変 更 年 月 日

2 0 0 1 年    3 月 1 4 日

[ 変 更 理 由 ]

新 規 登 録

住    所

香 川 県 高 松 市 丸 の 内 2 番 5 号

氏    名

株 式 会 社 テ ク ノ ネ ッ ト ワ ー ク 四 国

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**